


	<p>Hersteller-Teilenummer: BSB013NE2LXIXUMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 163A WDSO-2</p>
	<p>Datenblätter:  BSB013NE2LXIXUMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSB013NE2LXIXUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 163A WDSO-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 57W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Andere Namen	BSB013NE2LXICT
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4400pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 36A (Ta), 163A (Tc) 2.8W (Ta), 57W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Ta), 163A (Tc)

BSB013NE2LXIXUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSB013NE2LXIXUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSB013NE2LXIXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSB013NE2LXIXUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSB014N04LX3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 180A 2WDSO</p>	 <p>BSB012NE2LX Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 170A WDSO-2</p>	 <p>BSB012NE2LXI INFINEON BSB012NE2LXI INFINEON</p>	 <p>BSB013NE2LXI Infineon Technologies BSB013NE2LXI Infineon Technologies</p>
 <p>BSB012NE2LXIXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 170A WDSO</p>	 <p>BSB014N04LX3G INFINEON BSB014N04LX3G INFINEON</p>	 <p>BSB012NE2LX5G INFINEON BSB012NE2LX5G INFINEON</p>	 <p>BSB014N04LX3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 180A 2WDSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSB013NE2LXIXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSB013NE2LXIXUMA1 Datenblatt	BSB013NE2LXIXUMA1-Datenblätter	BSB013NE2LXIXUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSB013NE2LXIXUMA1
BSB013NE2LXIXUMA1 Electronic	BSB013NE2LXIXUMA1-Komponenten	BSB013NE2LXIXUMA1-Verteiler	BSB013NE2LXIXUMA1-Bild	BSB013NE2LXIXUMA1-Teil
BSB013NE2LXIXUMA1 Preis	BSB013NE2LXIXUMA1 Hersteller	BSB013NE2LXIXUMA1 Bild	BSB013NE2LXIXUMA1 Aktie	BSB013NE2LXIXUMA1 Inventar
BSB013NE2LXIXUMA1 Neu	BSB013NE2LXIXUMA1 Original	BSB013NE2LXIXUMA1 garantiert	BSB013NE2LXIXUMA1 RFQ	BSB013NE2LXIXUMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited